

Rockchip Developer Guide USB PHY

发布版本: 1.1

作者邮箱: wulf@rock-chips.com

日期: 2019-01-09

文档密级: 内部资料

概述

本文档提供 Rockchip 平台 USB PHYs 的开发指南, 通过该文档可以更加快速地了解 USB PHYs 的硬件设计框架、主要寄存器说明、PHY的功耗管理、PHY的tuning流程以及PHY的常见问题处理等。本文档可作为 USB PHYs 驱动开发的参考文档, 但不能替代PHY的手册。

产品版本

芯片名称	内核版本
所有芯片(包括 29 系列、30 系列、31 系列、32 系列、33 系列、PX 系列、1108)	所有内核版本

读者对象 本文档 (本指南) 主要适用于以下工程师:

软件工程师

硬件工程师

技术支持工程师

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2018-05-21	V1.0	吴良峰	初始版本
2019-01-09	V1.1	吴良峰	使用markdownlint修订格式

Rockchip Developer Guide USB PHY

[1 USB PHY 支持列表](#)

[2 USB2.0 PHY](#)

[2.1 Innosilicon USB2.0 PHY](#)

[2.1.1 PHY 的硬件框架](#)

[2.1.2 主要寄存器说明](#)

[2.1.3 参考电阻 USBRBIAS 说明](#)

[2.1.4 PHY 的供电及功耗管理](#)

[2.1.4.1 PHY 的供电](#)

[2.1.4.2 PHY 的功耗管理](#)

[2.1.5 PHY clk 管理](#)

- 2.1.6 PHY tuning 流程
- 2.2 Synopsys USB2.0 PHY
 - 2.2.1 PHY 的硬件框架
 - 2.2.2 主要寄存器说明
 - 2.2.3 参考电阻 REXT 说明
 - 2.2.4 PHY 的供电及功耗管理
 - 2.2.4.1 PHY 的供电
 - 2.2.4.2 PHY 的功耗管理
 - 2.2.5 PHY clk 管理
 - 2.2.6 PHY tuning 流程

3 USB3.0 PHY

- 3.1 Innosilicon USB3.0 PHY
 - 3.1.1 PHY 的硬件框架
 - 3.1.2 主要寄存器说明
 - 3.1.3 参考电阻说明
 - 3.1.4 PHY 的供电及功耗管理
 - 3.1.4.1 PHY 的供电
 - 3.1.4.2 PHY 的功耗管理
 - 3.1.5 PHY reset 和 recover 时序要求
 - 3.1.5.1 PHY reset 时序
 - 3.1.5.2 PHY recover 时序
 - 3.1.6 PHY tuning 流程
- 3.2 Cadence Type-C PHY
 - 3.2.1 PHY 的硬件框架
 - 3.2.2 主要寄存器说明
 - 3.2.3 参考电阻说明
 - 3.2.4 PHY 的供电及功耗管理
 - 3.2.4.1 PHY 的供电
 - 3.2.4.2 PHY 的功耗管理
 - 3.2.5 PHY reset
 - 3.2.6 PHY tuning 流程

4 PHY常见问题总结

- 4.1 通过tuning USB2.0 PHY 可以解决哪些问题
- 4.2 通过调整噪声阈值解决USB HS设备枚举失败的问题
- 4.3 通过调整断开检测阈值解决USB异常断开的问题
- 4.4 通过B_sessionvalid reference tuning解决ADB连接问题
- 4.5 Innosilicon LS/FS 信号问题
- 4.7 RK312x/RK3368 HS 握手失败问题
- 4.8 RK3228H/RK3328 USB3.0 PHY 若干问题

1 USB PHY 支持列表

Rockchip 采用的 USB PHY 主要有如下四种：

- USB2.0 PHY [Vendor: Innosilicon]
- USB3.0 PHY [Vendor: Innosilicon]
- USB2.0 PHY [Vendor: Synopsys]
- Type-C PHY [Vendor: Cadence]

如下表 1-1 为各芯片采用的 USB PHY，其中 [1 × port] 表示一个 PHY 支持一个 USB port，[2 × ports] 表示一个 PHY 支持两个 USB port。

表1-1 Rockchip 平台 USB PHY 支持列表

芯 片/ PHY	USB2 PHY [Inno]	USB3 PHY [Inno]	USB2 PHY [Synopsys]	Type-C PHY [Cadence]
RK3066				
RK3188	N	N	Y [1 × port]	N
RK3288				
RK302X	Y [1 × port]	N	N	N
RK303X				
RK312X				
RK322X				
RK3308	Y [2 × ports]	N	N	N
RK3326				
RK3368				
PX30				
RK3228H	Y	Y	N	N
RK3328				
RK3399	Y	N	N	Y

2 USB2.0 PHY

2.1 Innosilicon USB2.0 PHY

2.1.1 PHY 的硬件框架

Innosilicon USB2.0 PHY的硬件框架如下图2-1所示，主要包括五个子模块：Transceiver block, PLL clock multiplier, digital UTMI+ core, automatic test functionality, OTG Circuitry (optional)。

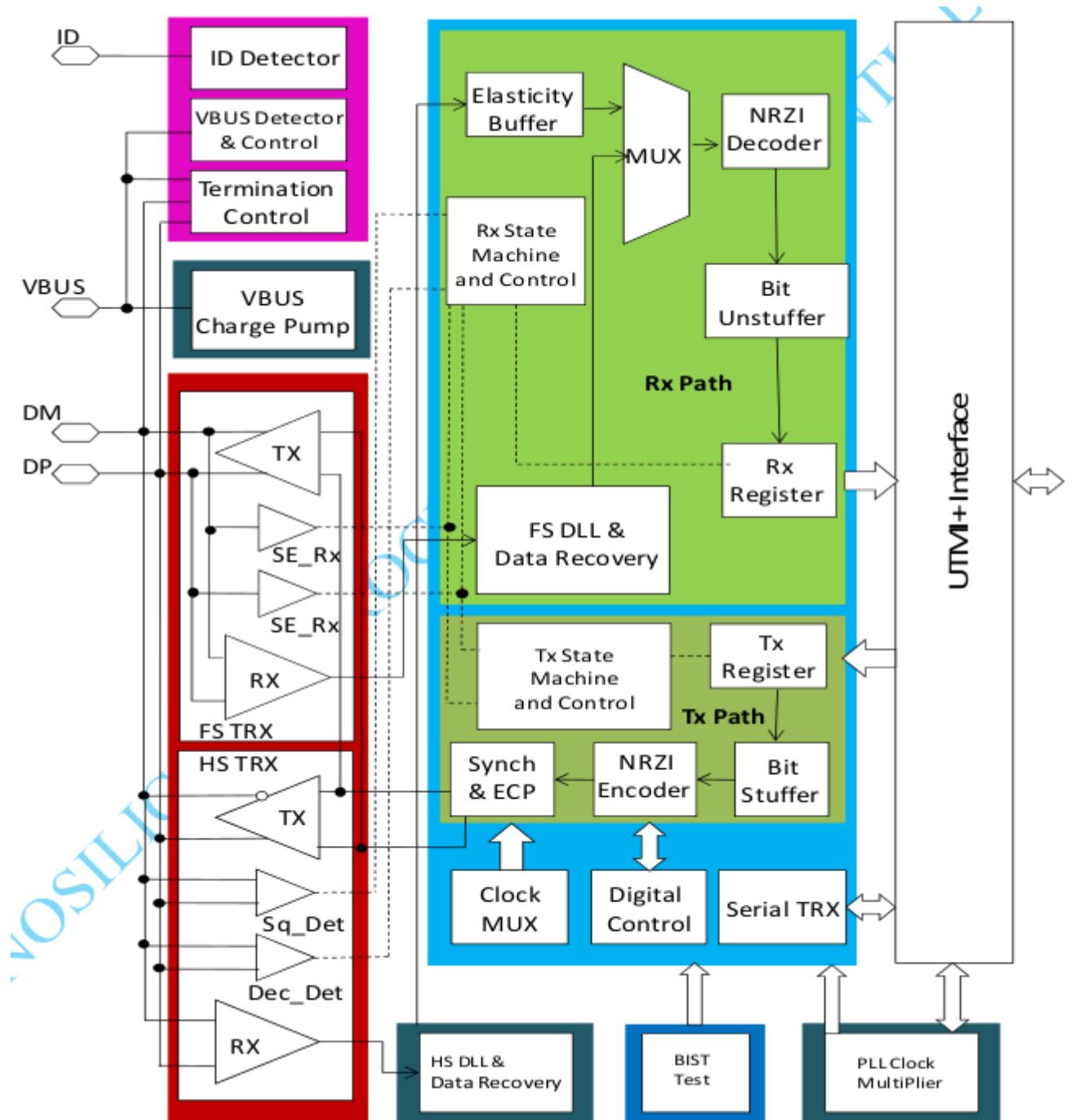


图2-1 Block Diagram of Inno USB 2.0 PHY

2.1.2 主要寄存器说明

表2-1 Inno USB2.0 PHY Port0 主要寄存器

Bit	Reset Value	Description
2:0	3'b000	<p>HS eye diagram adjust, open HS pre-emphasize function to increase HS slew rate, only used when large cap loading is attached.</p> <p>001:open pre-emphasize in sof or eop state 010: open pre-emphasize in chirp state 100: open pre-emphasize in non-chirp state 111: always open pre-emphasize</p> <p>该寄存器用于 HS 眼图预加重的调整, 建议设置为 3'b100</p> <p>see Note2</p>
115, 4:3	3'b011	<p>Hs slew rate tuning bits, more one represents larger slew rate , 111 the maximum and 001 the minimum, 000 will shut down the high speed driver output</p> <p>该寄存器用于 HS 眼图的 slew rate 调整。但作用很小。</p>
16:13	4'b1100	<p>A port squelch trigger point configure</p> <p>4b'0000 : 112.5mv 4b'0001 : 150mv 4b'0010 : 87.5mv 4b'0011 : 162.5mv 4b'0100 : 100mv 4b'0101 : 137.5mv 4b'0110 : 75mv 4b'0111 : 150mv 4b'1000 : 125mv 4b'1001 : 162.5mv 4b'1010 : 100mv 4b'1011 : 175mv 4b'1100 : 150mv(default) 4b'1101 : 187.5mv 4b'1110 : 125mv 4b'1111 : 200mv</p> <p>该寄存器用于噪声阈值调整, 建议用默认值 150mv。通过调整噪声阈值, 可以解决 USB 外设异常断开的问题, 参考: 4.2 通过调整噪声阈值解决USB HS设备枚举失败的问题</p>
36:29	8'b0011_1111	<p>HS eye height tuning ,more zeros represent bigger eye, more ones represent smaller eye</p> <p>该寄存器用于调整 HS 眼图的高度。只有在 bit[43:42] = 2'b11, 即进入 bypass 状态后, 才能生效。该寄存器可以调节的范围很大, 但因为 bypass 状态下, USB PHY 会失去自动调整的能力, 容易引起兼容性的问题。所以, 不建议设置该寄存器。</p>

Bit	Reset Value	Description
41:37	5'b10111	<p>HS/FS driver strength tuning</p> <p>该寄存器用于调整 HS 眼图的驱动强度。只有在 [42] = 1'b1, 并且 [57] = 1'b0 时, 即 bypass ODT, 才能生效。默认值为 5b'10111, 最高位必须为 1, [41], [40],[39],[38],[37] 权重分别为 16,8,4,2,1。权重越大, 驱动强度越小, 5b'11111 对应的驱动强度最小, 5b'10000 对应的驱动强度最大。因为 bypass ODT 可能引起兼容性问题, 所以, 建议尽量不要设置该寄存器。</p> <p>see Note3</p>
43:42	2'b00	<p>auto compensation bypass , "11" will bypass current and ODT compensation, customers can set the driver strength and current manually.</p> <p>For larger HS eye height, customer can give more "0" for bit [36:29] ;</p> <p>For larger HS/FS/LS slew rate, give more "1" for bit[41:37].</p> <p>该寄存器用于 bypass 电流和电阻的自动调节电路, 可明显提高 USB 眼图的软件 tuning 范围。但 bypass 后, USB PHY 会失去自动调节的能力, 可能引起兼容性问题, 所以, 不建议设置该寄存器。如果确实需要 bypass, 建议设置 [43:42] = 2'b01, [57] = 1b'0 即 bypass comp 电路中的电阻自动调节电路, 保留电流自动调节电路, 在该配置下, 可以设置 [41:37], 不能设置 [36:29]</p>
49:47	3'b000	<p>ODT Compensation voltage reference</p> <p>3'b000 : 268mV(default)</p> <p>3'b001 : 262mV</p> <p>3'b010 : 250mV</p> <p>3'b011 : 237.5mV</p> <p>3'b100 : 275mV</p> <p>3'b101 : 281mV</p> <p>3'b110 : 293mV</p> <p>3'b111 : 300mV</p> <p>调高电阻校准点, 可以提高 USB 眼图的幅度 (推荐优先尝试100/101, 最大为 3b'111) 。</p> <p>see Note4</p>
52:50	3'b000	<p>bias current tuning reference</p> <p>3'b000 : 200mV(default)</p> <p>3'b001 : 212.5mV</p> <p>3'b010 : 225mV</p> <p>3'b011 : 237.5mV</p> <p>3'b100 : 250mV</p> <p>3'b101 : 187.5mV</p> <p>3'b110 : 175mV</p> <p>3'b111 : 162.5mV</p> <p>内部 current buffer 参考点, 对眼图的影响很小, 建议用默认值即可。</p>

Bit	Reset Value	Description
55:53	3'b000	<p>compensation current tuning reference 3'b000 : 400mV(default) 3'b001 : 362.5mV 3'b010 : 375mV 3'b011 : 387.5mV 3'b100 : 412.5mV 3'b101 : 425mV 3'b110 : 437.5mV 3'b111 : 450mV</p> <p>调高电流校准点，可以提高 USB 眼图的幅度（推荐优先尝试 100/101，最大为 3'b111）</p> <p>see Note4</p>
57	1'b1	<p>A port ODT auto refresh bypass, active low 该寄存器只有在 [42] = 1'b1 时，才有效。在 bypass ODT 的模式下，才可以设置 [41:37]，调整眼图的驱动强度。</p>
98	1'b1	<p>Turn off differential receiver in suspend mode to save power, active low. 该寄存器用于 PHY 的低功耗控制。参考2.1.4.2 PHY 的功耗管理</p>
100	1'b0	<p>force output B_sessionvalid asserted, active high 该寄存器可以设置 B_sessionvalid 为高，解决芯片端 otg_det pin 没有连接到 USB 接口的 VBUS pin，导致 VBUS 检测失效的问题。</p>
108:106	3'b000	<p>B_sessionvalid reference tuning 该寄存器用于调整 B_sessionvalid 的参考阈值，参考 4.4 通过B_sessionvalid reference tuning解决ADB连接问题</p>
126:123	4'b1101	<p>HOST disconnect detection trigger point configure, only used in HOST mode 0000 : 575mV 0001 : 600mV 1001 : 625mV 1101 : 650mV(default) 该寄存器用于调整 Host mode 的断开检测阈值，参考 4.3 通过调整断开检测阈值解决USB异常断开的问题</p>
127	1'b0	<p>vbus voltage level detection function power down 该寄存器用于使能 Device mode 的 vbus detect，只有使能该 bit 位，GRF (USB_GRF) 寄存器中的 bvalid 状态检测才有效果。</p>

- Note1: 表1-2 只给出了 Inno USB2 PHY Port0 的主要寄存器说明。Port1 的寄存器与 Port0 基本一致，只是 Bit 位置不同，请参考PHY的手册即可。
- Note2: bit0 为 SOF 和 EOP 的预加重，应该慎用，如果同时设置 bit[0] 和 [41:37] = 5'b10000，容易导致 disconnect 误判。此外，bit1 为 chrip state 预加重，也要慎用，可能会导致 high-speed 握手失败。

- Note3: 如果通过调整 bit[2:0], bit[115], bit[4:3], bit[55:53], bit[49:47] 这些寄存器, USB 眼图指标测试仍无法PASS, 可以考虑设置 bit[41:37]。设置方法是: 首先, 设置 [42] =1'b1, [57] = 1'b0, bypass comp 电路中的电阻自动调节电路, 但仍然保留电流自动调节电路(避免引起兼容性问题)。然后, 再根据USB眼图的测试结果, 动态调整 [41:37], 找到最佳的配置。更详细的设置方法, 请参考 [2.1.6 PHY tuning 流程](#)
- Note4: [49:47] 和 [55:53] 需要在打开校准模式后, 才能生效, 并且对同一个 **PHY** 的 **port0** 和 **port1** 同时生效。不同的PHY版本, 校准模式的控制寄存器可能不同, 比如:

RK3399 打开校准模式为 [199] = 1'b1

RK3328/RK3228H/PX30/RK3326/RK3308/RV1108 打开校准模式为:

[186:184] = 3b'000 (以默认的电流校准方式)

[186:184] = 3b'100 (以Port0的电流校准方式)

[186:184] = 3b'101 (以Port1的电流校准方式)

2.1.3 参考电阻 **USBRBIAS** 说明

参考电阻 **USBRBIAS** 在 **PHY** 手册中规定为 135Ω , 实际电路中, 一般采用 **$133\Omega \pm 10\%$** 的电阻。该阻值会影响 USB 信号的驱动强度, 所以建议尽量不要随意改动。在特殊情况下, 如 USB 电路的 DP/DM 阻抗由于硬件设计原因变大, 导致 USB 信号幅度降低, 并且通过软件 **tuning** 也无法提高幅度到标准值时, 可以考虑修改该参考电阻的阻值。修改参考电阻 **USBRBIAS** 的阻值, 应该遵循以下几个原则:

1. 阻值越小则输出强度越大, 出来的波形整体放大, 但对摆率 (slew rate) 没有影响;
2. 阻值允许的修改范围为 $\pm 10\%$, 超过该范围可能会存在兼容性问题;
3. 阻值会影响到同一个 **PHY** 的两个 **port**, 所以修改阻值后, 一定要重新测试 **PHY** 的两个 **port** 的眼图, 避免因幅度过大而触发 **disconnect** 信号, 造成 **device** 频繁 **disconnect/reconnect**;

2.1.4 **PHY** 的供电及功耗管理

2.1.4.1 **PHY** 的供电

PHY 的供电有三路 3.3V, 1.8V 和 1.0V, 如下表2-2所示。如果实际电路中, 这三路电压值超过规定的最大值或者低于规定的最小值, 都可能会导致 USB 连接异常。

表2-2 Inno USB2.0 **PHY** power supplies

Supply Voltage	Min	Typ	Max	Unit
USB_AVDD_3V3	3.0	3.3	3.6	V
USB_AVDD_1V8	1.62	1.8	1.98	V
USB_AVDD_1V0	0.9	1.0	1.1	V

一个典型的出错现象是, **VCCCORE1P0** 的电压超过了规定的最大值 1.1V, 导致 USB ADB 连接失败。解决方法请参考[4.3 通过B sessionvalid reference tuning解决ADB连接问题](#)

2.1.4.2 **PHY** 的功耗管理

1. 运行时的 **PHY** 功耗管理

系统运行时, 如果 USB2.0 port 没有工作, 则可以通过 GRF (或USB_GRF) 寄存器中的 utmi_sel, utmi_suspend_n, utmi_opmode, utmi_xcvrselect, utmi_termselect, utmi_dppulldown 以及 utmi_dmpulldown 来控制 USB2.0 PHY 进入 suspend。当检测到有 USB 连接时, 需要先 resume PHY, 才能开始 USB 枚举。详细的控制流程可以参考 USB2.0 PHY 的驱动 (drivers/phy/rockchip/phy-rockchip-inno-usb2.c)。

表2-3 运行时的 Inno USB2.0 PHY 功耗管理寄存器

Bit	Reset Value	Suspend Value	Description
8	1'b0	1'b1	utmi_dmpulldown 0 : DM 15 KOhm pull down disabled 1: DM 15 Kohm pull down enable
7	1'b0	1'b1	utmi_dppulldown 0 : DP 15 KOhm pull down disabled 1 : DP 15 Kohm pull down enable
6	1'b1	1'b1	utmi_termselect GRF termination select between FS/HS speed 1 : Full-speed terminations are enabled. 0 : High-speed terminations are enabled.
5:4	2'b01	2'b01	utmi_xcvrselect GRF transceiver select between FS/LS/HS speed 11 : Sends an LS packet on an FS bus or receives an LS packet. 10 : LS Transceiver 01 : FS Transceiver 00 : HS Transceiver
3:2	2'b00	2'b00	utmi_opmode GRF operational mode selection 11 : Normal operation without SYNC or EOP generation. If the XCVRSEL bus is not set to 00 while OPMODE[1:0] is set to 11, USB PHY behavior is undefined. 10 : Disable bit stuffing and NRZI encoding. 01 : Non-Driving 00 : Normal
1	1'b1	1'b0	utmi_suspend_n GRF suspend mode 1'b0 : suspend 1'b1 : normal
0	1'b0	1'b1	utmi_sel 1'b0 : select otg controller utmi interface to phy 1'b1 : select GRF utmi interface to phy

2. 待机时的 **PHY** 功耗管理

待机时的 **PHY** 功耗管理有如下两种方法, 推荐使用方法2。

- 方法1：关闭PHY的供电

关闭PHY的供电是最直接的节省功耗的方法，但有两个限制：

1. PHY的三路供电3.3V, 1.8V, 1.0V以及VDD_logic要同时关闭，否则会导致这四路电之间的漏电。
2. 关闭PHY的供电，则不支持USB唤醒系统（Remote wakeup）的功能。

- 方法2：设置PHY进入低功耗模式

该方法是通过GRF(USB_GRF)寄存器来控制PHY进入低功耗模式。

目前，PHY驱动(`drivers/phy/rockchip/phy-rockchip-inno-usb2.c`)支持两级低功耗设置。默认开启一级低功耗配置，关闭二级低功耗配置。因为二级低功耗配置下，linestate和bvalid中断都会失效。如果要开启二级低功耗配置，需要在DTS中增加属性“rockchip,low-power-mode”。

一级低功耗配置：

表2-4 Inno USB2.0 PHY一级低功耗寄存器配置

Bit	Reset Value	Suspend Value	Description
98	1'b1	1'b0	Turn off differential receiver in suspend mode to save power, active low

二级低功耗配置：

表2-5 Inno USB2.0 PHY二级低功耗寄存器配置

Bit	Reset Value	Suspend Value	Description
46	1'b0	1'b1	Battery charging related register
127	1'b0	1'b1	vbus voltage level detection function power down, active high

Note: 在二级低功耗的配置下，linestate和bvalid中断都会失效，只有id中断起作用。

表2-6 Inno USB2.0 PHY低功耗数据（以PX30/RK3326实测数据为例）

供电电源	运行时低功耗	待机一级低功耗	待机二级低功耗
USB_AVDD_1V0	0.27 mA	0.27 mA	0.006 mA
USB_AVDD_1V8	0.73 mA	0.1 mA	0.02 mA
USB_AVDD_3V3	0 mA	0 mA	0 mA

2.1.5 PHY clk 管理

PHY 输出给 USB 控制器的时钟主要有 480 MHz clk 和 utmi clk，这两个时钟如果没有管理好，会导致 USB 控制器工作异常。对于这两个时钟的管理，需要注意以下两点：

1. 480 MHz clk的管理

对于 Inno USB2.0 PHY 2 x ports，两个 ports 共同使用一个 480 MHz clk，由GRF寄存器的 suspend assert 和 COMMONONNN 联合控制。控制方法如下：

两个 port 都进 suspend，并且 COMMONONNN 为1，才会关闭 480 MHz clk。当 480 MHz clk 被关闭后，如果有其他 IP 需要使用该 clk，可以将 COMMONONNN 重新设置为 0 即可，不需要重新 reset PHY，但需要等待 1 ms，clk 才能稳定。

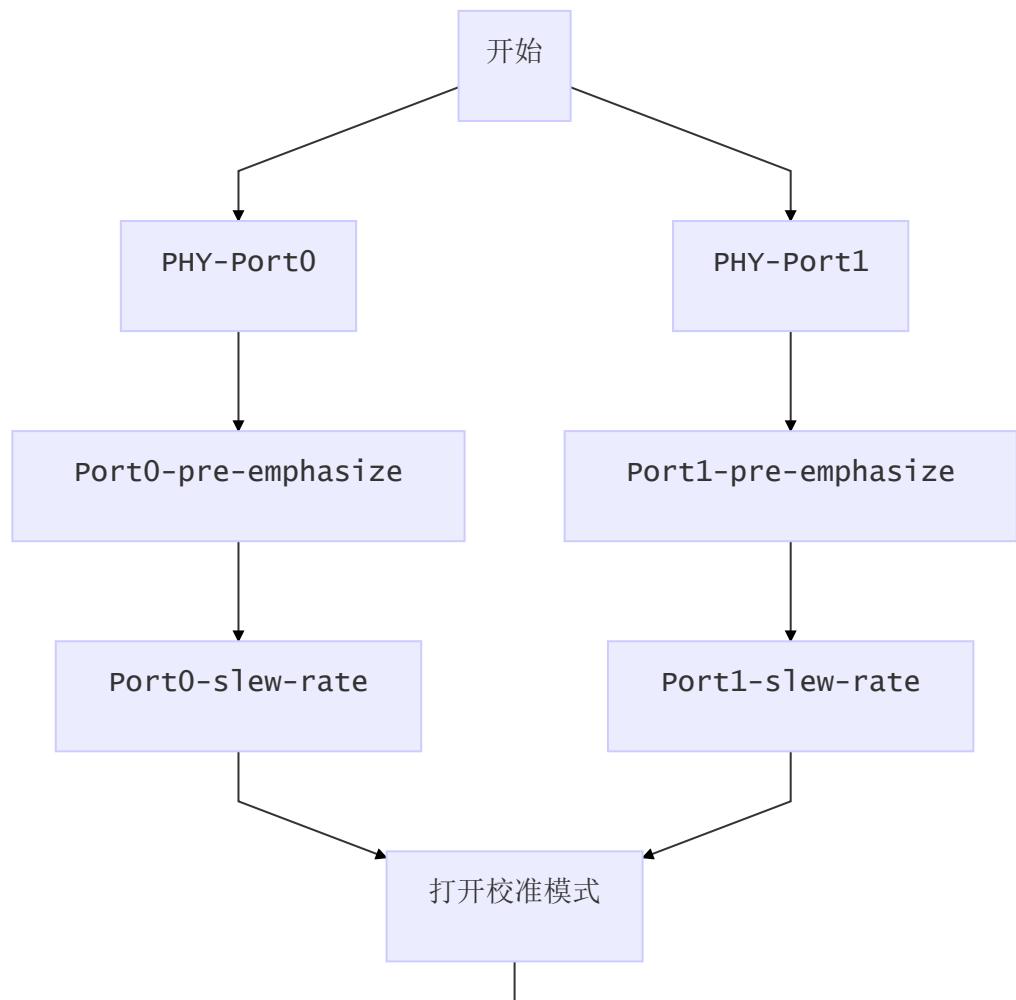
两个 port，如果有一个没有进入 suspend，则不会关闭 480 MHz clk。两个 port，如果都进入 suspend，但 COMMONONNN 为 0，也不会关闭 480 MHz clk。

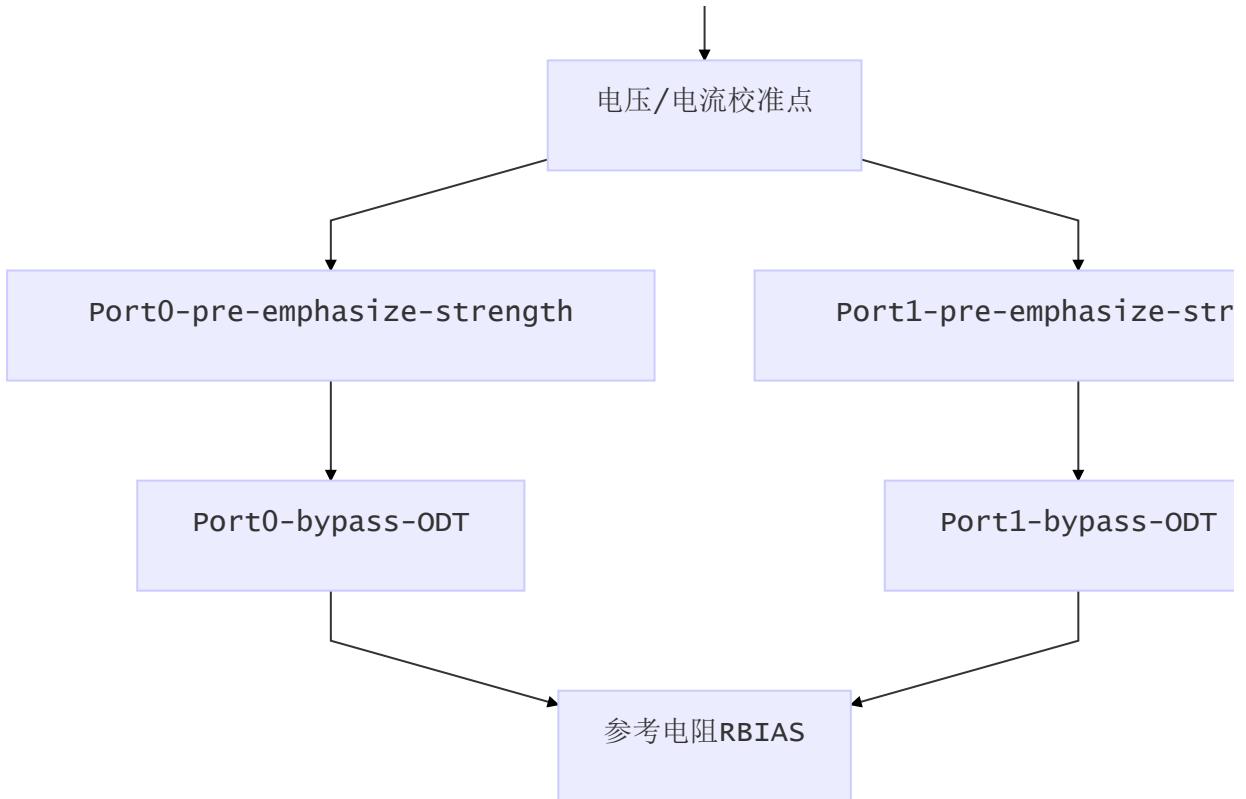
2. utmi clk的管理

对于 Inno USB2.0 PHY 2 x ports，每个 port 有自己对应的 utmi clk，并且，只由 port 自己的 suspend assert 控制。当 port 进入 suspend，utmi clk 会被关闭。当 port 退出 suspend，utmi clk 会被重新开启，但需要等待 1.5 ~ 2ms，utmi clk 才能稳定。

2.1.6 PHY tuning 流程

Inno USB2.0 PHY (2 x ports) tuning 的流程图如下：





以RK3399 USB2.0 PHY HS tuning为例（RK3399 具有两个 USB2.0 PHY，每个 PHY 有2个port），tuning 流程如下
Stage1 ~ stage5。

Stage1. Port0 & Port1 pre-emphasize & slew rate tuning

Port0 tuning:

[2:0] = 3'b100; //open Port0 pre-emphasize in non-chirp state

{[115],[4:3]} = 3'b101 //设置 Port0 slew-rate 最大，注意：3'b101强度最大，而不是3'b111

Port1 tuning:

[210:208] = 3'b100; //open Port1 pre-emphasize in non-chirp state

{[323],[212:211]} = 3'b101; //设置 Port1 slew-rate 最大，注意：3'b101强度最大，而不是3'b111

Stage2. 打开校准模式，调整电压/电流校准点

注意：如下寄存器的调整对 Port0 和 Port1 同时生效。

[199] = 1'b1; //变换校准模式（这一位寄存器只存在于port0上，但对port0和port1同时有作用），

//这是一个备用的校准模式，通常是不开放的。在新的校准模式下，

//调节 [55:53], [49:47]才能有效。

如果通过 Stage1 的tuning，眼图仍不能得到明显改善，可在此基础上尝试调高电流校准点和电阻校准点。

[55:53] = 3'b101(default); //调高电流校准点(推荐优先尝试100/101，最大为3b'111)

```
[49:47] = 3'b101(default); //调高电阻校准点(推荐优先尝试100/101, 最大为3b'111)
```

此外, 还可以调整[52:50] (内部current buffer参考点), 但作用比较小。

Stage3. 调整预加重强度

```
[194:192] = 3'b011; //调节 Port0 HS driver预加重强度, “111”强度最大。
```

//其中[194], [193], [192]的权重依次为1, 2, 4

```
[402:400] = 3'b011; //调节 Port1 HS driver预加重强度, “111”强度最大。
```

Stage4. Bypass ODT & driver strength tuning

如果通过Stage1～stage3的常规 PHY tuning 方法, 眼图测试仍然无法pass, 可以考虑bypass ODT, 需要注意的是, Port0 和 Port1 可以分开bypass ODT 和 调整驱动强度。

Port0 bypass ODT & driver strength tuning:

```
[42] = 1'b1; //bypass comp 电路中的电阻自动调节电路, 保留电流自动调节电路,
```

//当 Port1 对应的 [250] 没有置1时, 该 bit 同时对 Port0 和 Port1 产生作用,

//也即设置 [41:37] 会同时影响 Port0 和 Port1。当 Port1 对应的 [250] 置1时,

//则该 bit 只会对 Port0 产生作用, 也即 [41:37] 只控制 Port0, 而 [249:245] 控制 Port1

```
[57] = 1'b0; //Port0 ODT auto refresh bypass
```

```
[41:37] = 5b' 10001或5'b10000
```

//Port0 驱动强度调整, 默认值为5b'10111, 最高位必须为1,

//[41],[40],[39],[38],[37]权重分别为16,8,4,2,1。权重越大, 驱动强度越小,

//5b'11111对应的驱动强度最小, 5b'10000对应的驱动强度最大

Port1 bypass ODT & driver strength tuning:

```
[250] = 1'b1; //bypass comp 电路中的电阻自动调节电路, 保留电流自动调节电路,
```

//只对 Port1 产生作用。当该bit置1, 则 [249:245] 可以并且只能控制 Port1,

//当该bit为0, 则 [249:245] 不能控制 Port1, 而是由[41:37]来控制 Port1。

```
[265] = 1'b0; //Port1 ODT auto refresh bypass (类似Port0 [57])
```

```
[249:245] //Port1 驱动强度调整, 类似 Port0 的[41:37]
```

Stage5. 调整参考电阻**RBIAS**的阻值

如果软件tuning PHY, 仍然无法保证眼图测试pass, 最后只能考虑调整参考电阻的方法, 请参考 [2.1.3 参考电阻 USBRBIAS 说明](#)

2.2 Synopsys USB2.0 PHY

考虑到 Synopsys USB2.0 PHY 只用于较早的几款芯片 (RK3066/RK3188/RK3288), 当前的主流芯片和后续的芯片 USB2.0 PHY 都是采用 Innosilicon 提供的IP, 所以本章节只作简单介绍。

2.2.1 PHY 的硬件框架

Synopsys USB2.0 PHY的硬件框架如下图2-2所示，主要包括三个子模块：Common block, Transceiver block, OTG block。各模块的具体作用在PHY手册中有详细说明，这里不再赘述。

需要注意的是，Rockchip平台的 Synopsys USB2.0 PHY 都是只支持一个Port，不像Inno USB2.0 PHY可以支持两个Ports。

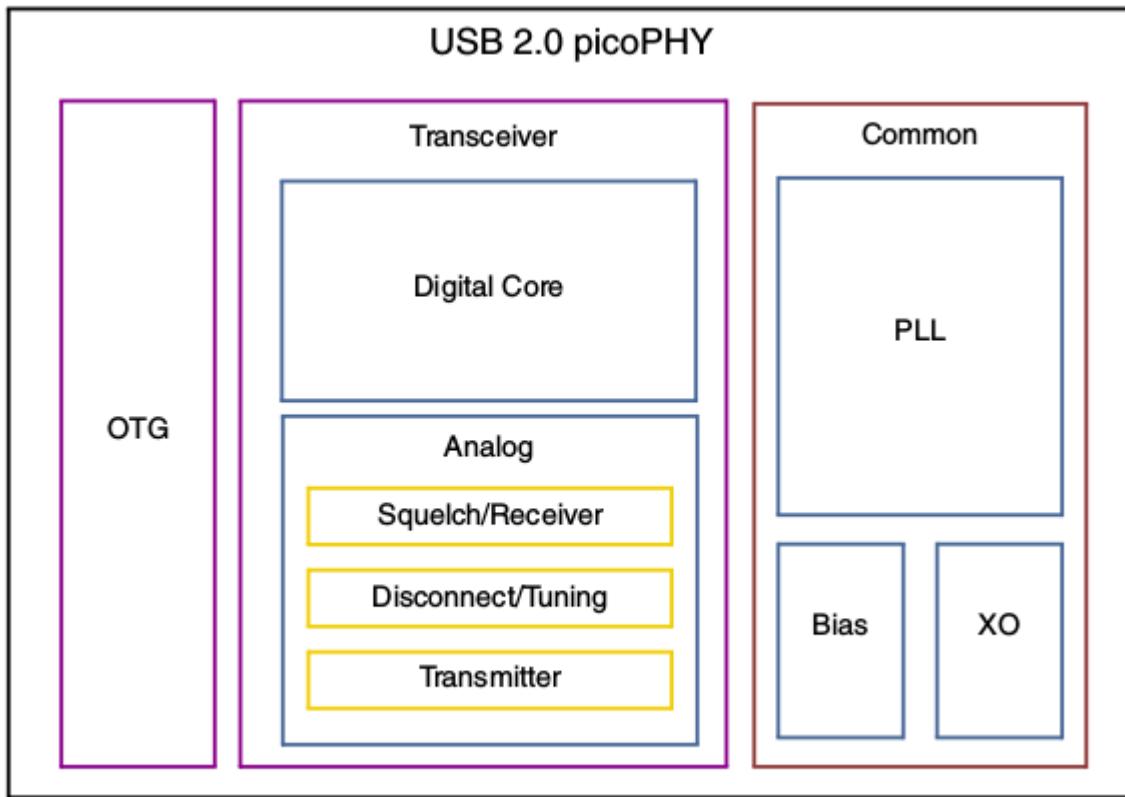


图2-2 Synopsys USB 2.0 picoPHY One-Port Functional Block Diagram

2.2.2 主要寄存器说明

表2-7 Synopsys USB2.0 PHY 主要寄存器

Signal	I/O	Description
COMPDISTUNE[2:0]	I	<p>Disconnect Threshold Adjustment</p> <p>Function: This bus adjusts the voltage level for the threshold used to detect a disconnect event at the host.</p> <p>111: + 4.5% 110: + 3% 101: + 1.5% 100: Design default 011: - 1.5% 010: - 3% 001: - 4.5% 000: - 6%</p>
OTGTUNE[2:0]	I	<p>VBUS Valid Threshold Adjustment</p> <p>Function: This bus adjusts the voltage level for the VBUS Valid threshold.</p> <p>111: + 9% 110: + 6% 101: + 3% 100: Design default 011: - 3% 010: - 6% 001: - 9% 000: - 12%</p>
SQRXTUNE[2:0]	I	<p>Squelch Threshold Adjustment</p> <p>Function: This bus adjusts the voltage level for the threshold used to detect valid high-speed data.</p> <p>111: - 20% 110: - 15% 101: - 10% 100: - 5% 011: Design default 010: + 5% 001: + 10%</p>
TXFSLSTUNE[3:0]	I	<p>FS/LS Source Impedance Adjustment</p> <p>Function: This bus adjusts the low- and full-speed single-ended source impedance while driving high. The following adjustment values are based on nominal process, voltage, and temperature.</p> <p>1111: - 5% 0111: - 2.5% 0011: Design default 0001: + 2.5% 0000: + 5%</p>

Signal	I/O	Description
TXPREEMPAMPTUNE[1:0]	I	<p>HS Transmitter Pre-Emphasis Current Control</p> <p>Function: This signal controls the amount of current sourced to DP0 and DM0 after a J-to-K or K-to-J transition. The HS Transmitter pre-emphasis current is defined in terms of unit amounts. One unit amount is approximately 600 μA and is defined as 1X pre-emphasis current.</p> <p>11: HS Transmitter pre-emphasis circuit sources 3X pre-emphasis current.</p> <p>10: HS Transmitter pre-emphasis circuit sources 2X pre-emphasis current.</p> <p>01 (design default): HS Transmitter pre-emphasis circuit sources 1X pre-emphasis current.</p> <p>00: HS Transmitter pre-emphasis is disabled.</p>
TXPREEMPPULSETUNE	I	<p>HS Transmitter Pre-Emphasis Duration Control</p> <p>Function: This signal controls the duration for which the HS pre-emphasis current is sourced onto DP0 or DM0. The HS Transmitter pre-emphasis duration is defined in terms of unit amounts. One unit of pre-emphasis duration is approximately 580 ps and is defined as 1X pre-emphasis duration. This signal is valid only if either TXPREEMPAMPTUNE0[1] or TXPREEMPAMPTUNE0[0] is set to 1'b1.</p> <p>1: 1X, short pre-emphasis current duration</p> <p>0 (design default): 2X, long pre-emphasis current duration</p>
TXRISETUNE[1:0]	I	<p>HS Transmitter Rise/Fall Time Adjustment</p> <p>Function: This bus adjusts the rise/fall times of the high-speed waveform.</p> <p>11: - 20%</p> <p>10: - 15%</p> <p>01: Design default</p> <p>00: + 10%</p>
TXVREFTUNE[3:0]	I	<p>HS DC Voltage Level Adjustment</p> <p>Function: This bus adjusts the high-speed DC level voltage.</p>
TXHSXVTUNE[1:0]	I	<p>Transmitter High-Speed Crossover Adjustment</p> <p>Function: This bus adjusts the voltage at which the DP0 and DM0 signals cross while transmitting in HS mode.</p>

Signal	I/O	Description
TXRESTUNE[1:0]	I	<p>USB Source Impedance Adjustment Function: In some applications, there can be significant series resistance on the D+ and D- paths between the transceiver and cable. This bus adjusts the driver source impedance to compensate for added series resistance on the USB.</p> <p>Note: Any setting other than the default can result in source impedance variation across process, voltage, and temperature conditions that does not meet USB 2.0 specification limits.</p> <p>11: Source impedance is decreased by approximately 4 Ω. 10: Source impedance is decreased by approximately 2 Ω. 01: Design default 00: Source impedance is increased by approximately 1.5 Ω.</p>

2.2.3 参考电阻 REXT 说明

根据PHY手册的设计要求, RK3066/RK3188/RK3288 的参考电阻 External resistor (REXT) 如下表2-8, , 在电路设计中, 请严格按照参考阻值的要求进行设计。如果需要调整DP/DM的阻抗, 可以调整 USB PHY 的寄存器 TXRESTUNE[1:0], 具体参考 [2.2.2 主要寄存器说明](#)

表2-8 Synopsys USB2.0 PHY REXT

芯片	参考电阻 REXT
RK3066/RK3188	43.2 Ω (± 1%)
RK3288	200 Ω

2.2.4 PHY 的供电及功耗管理

2.2.4.1 PHY 的供电

根据PHY手册的设计要求, RK3066/RK3188/RK3288 的供电如下表2-9所示。

表2-9 Synopsys USB2.0 PHY power supplies

芯片	Analog power supplies	Digital power supply
RK3066/RK3188	3.3 V (+ 10%, - 7%) 2.5 V (+ 10%, - 7%)	1.1 V (+ 10%, - 7%)
RK3288	3.3 V (± 10%) 1.8 V (± 10%)	1.0 V (± 10%)

2.2.4.2 PHY 的功耗管理

1. 运行时的 PHY 功耗管理

Synopsys USB2.0 PHY 的运行功耗管理与 Inno USB2.0 PHY 类似，也是通过 GRF（或USB_GRF）寄存器中的 utmi_sel, utmi_suspend_n, utmi_opmode, utmi_xcvrselect, utmi_termselect, utmi_dppulldown 以及 utmi_dmpulldown 来控制 USB2.0 PHY 进入 suspend。寄存器的具体配置方法，请参考 [2.1.4.2 PHY 的功耗管理](#) 章节。

2. 待机时的 **PHY** 功耗管理

Synopsys USB2.0 PHY 的待机功耗管理与 Inno USB2.0 PHY 有所不同。Synopsys USB2.0 PHY 可以通过控制 SIDDQ（通常在GRF寄存器中）来关闭PHY的模拟电路，从而让PHY进入低功耗模式。SIDDQ 的功能描述如下表2-10 所示。

表2-10 Synopsys USB2.0 PHY 待机低功耗配置

Bit	Reset Value	Suspend Value	Description
SIDDQ	1'b0	1'b1	<p>Function: This test signal enables you to perform IDQ testing by powering down all analog blocks. Before asserting SIDDQ, ensure that VDATSRCENB0, VDATDETENB0, DCDENB0, BYPASSSEL0, ADPPRBENB0, and TESTBURNIN are set to 1'b0.</p> <p>1: The analog blocks are powered down.</p> <p>0: The analog blocks are powered up.</p> <p>Note: 如果有使能 Bypass Uart 的功能，在待机时，需要关闭 Bypass 功能（BYPASSSEL0 = 1'b0），否则会增加PHY的功耗。</p>

2.2.5 **PHY clk** 管理

Synopsys USB2.0 PHY 的clk管理与 Inno USB2.0 PHY 类似，也是通过GRF寄存器的 suspend assert 和 COMMONONNN 联合控制。请参考 [2.1.5 PHY clk 管理](#)

2.2.6 **PHY tuning** 流程

Synopsys USB2.0 PHY 的兼容性比较好，所以一般不用tuning PHY。如果因为硬件电路设计问题，需要进行 tuning，可以根据表1-8 Synopsys USB2.0 PHY 主要寄存器的说明进行调整，tuning 的流程相比 Inno USB2.0 PHY 简单得多，主要调整眼图的预加重（TXPREEMPAMPTUNE[1:0]）和斜率（TXRISETUNE[1:0]）。

3 USB3.0 PHY

3.1 Innosilicon USB3.0 PHY

Inno USB3.0 PHY 只支持Super-speed，没有向下兼容High-Speed，所以需要和Inno USB2.0 PHY组成一个Combo PHY。如下图3-1 是一个典型的 USB3.0 OTG 架构图。

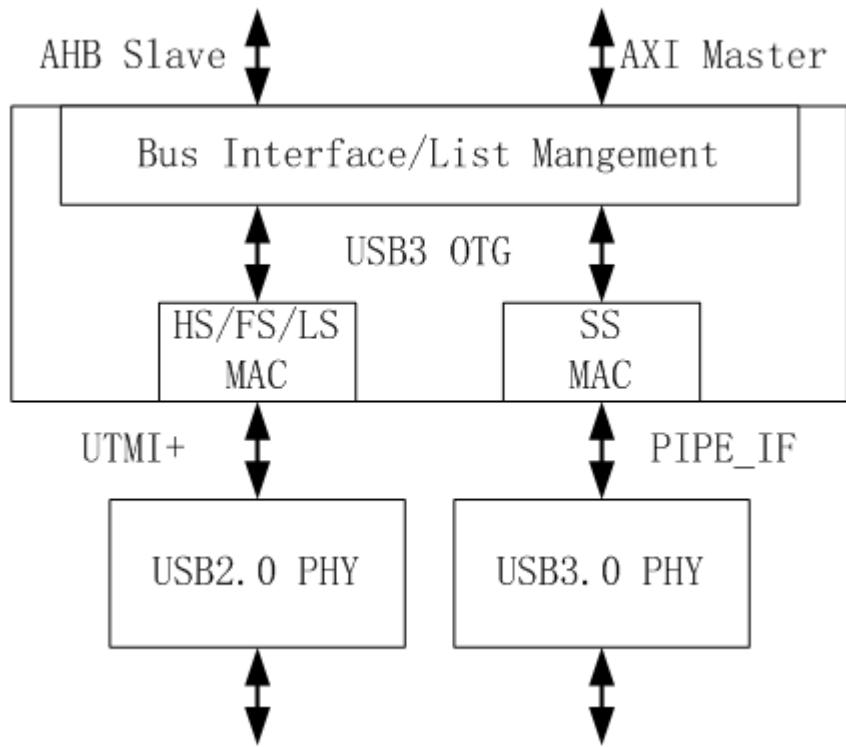


图3-1 USB3.0 OTG Block Diagram

3.1.1 PHY 的硬件框架

Innosilicon USB3.0 PHY 的硬件框架如下图3-2所示，主要包括：Data serialization and de-serialization, 8b/10b encoding, analog buffers, elastic buffers and receiver detection。

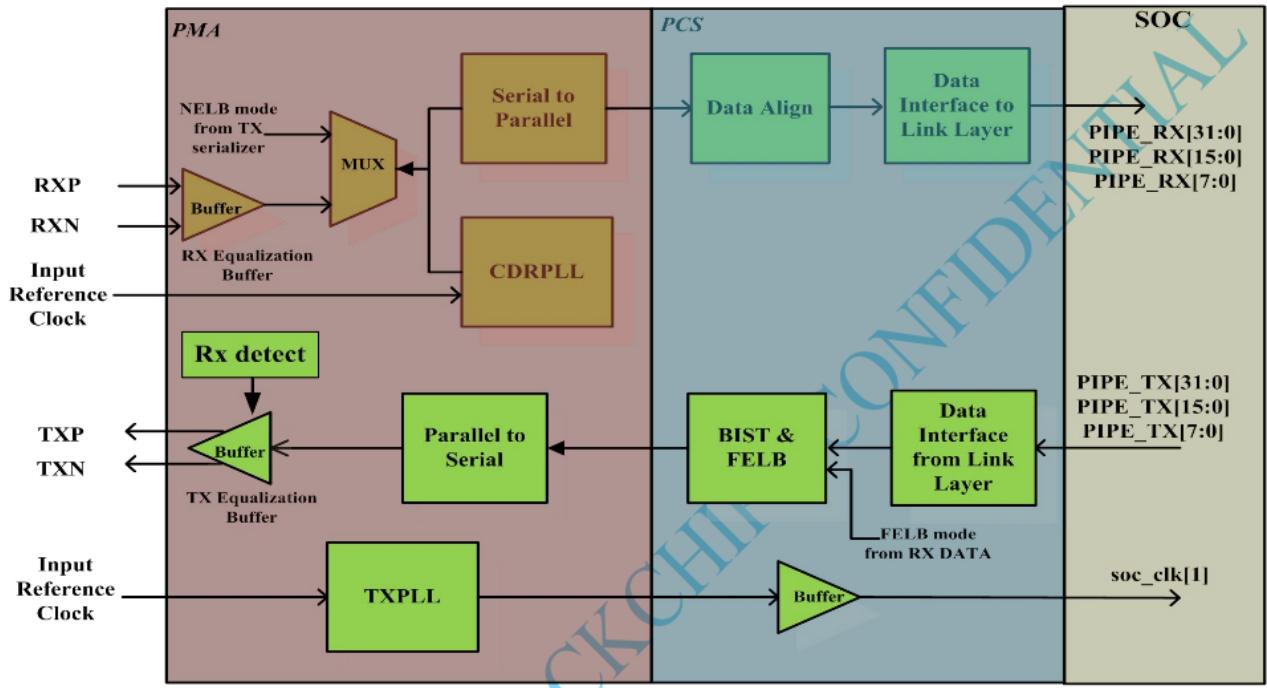


图3-2 Inno USB3.0 PHY Block Diagram

3.1.2 主要寄存器说明

USB3 PHY寄存器的说明，请参考 Inno USB3.0 PHY 手册 “Table 6.1 USB3.0 Registers”章节。一些重要的寄存器及配置说明，将再后续的章节中，分别介绍。

3.1.3 参考电阻说明

根据 Inno USB3.0 PHY 手册的设计要求, PHY的参考电阻 RBIAS 如下表3-1, 在电路设计中, 请严格按照参考阻值的要求进行设计。

表3-1 Inno USB3.0 PHY 参考电阻RBIAS

芯片	参考电阻 RBIAS
RK3228H/RK3328	2K ± 1% external resistance bias to ground

3.1.4 PHY 的供电及功耗管理

3.1.4.1 PHY 的供电

根据 Inno USB3.0 PHY 手册的设计要求, PHY的供电如下表3-2所示。

表3-2 Inno USB3.0 PHY power supplies

芯片	Parameter	Notes	Min	Typical	Max
RK3228H/RK3328	VCCA1P8	1.8 V analog supply voltage for CDR	1.62	1.8	1.98
RK3228H/RK3328	VCCD1P0	1.0 V analog supply voltage for PLL, CDR and clock tree power	0.9	1.0	1.1

3.1.4.2 PHY 的功耗管理

表3-3 是 Inno USB3.0 PHY 手册中提供的理论功耗和实际测试的功耗（基于RK3228H EVB）的对比。可以看出, 实际功耗比理论功耗大很多。同时, 因为**USB3.0 PHY 在 P3 state, link training** 失败, 导致无法识别外设, 所以, 目前运行时的低功耗, 只能设置在 **P2 state**, 运行时的功耗偏高。

表3-3 Inno USB3.0 PHY 功耗

Power State	理论功耗	实际功耗 (RK3228H)
P0	60 mW	120 mW VCCA1P8 : 47.9 mA VCCD1P0 : 35 mA
P1	40 mW	N.A
P2	20 mW	76 mW VCCA1P8 : 32.7 mA VCCD1P0 : 18.1 mA
P3	1.1 mW	< 1 mW

Note:

- 理论功耗的测试条件是: VCCA1P8 = 1.8 V, VCCD1P0 = 1.0 V, VoltageSwing = 1000mVdiffpp;
- 实际功耗的测试条件是:

P0：连接USB3.0 Disk，并播放Disk中的视频；

P2：静态桌面，USB3.0未连接外设；

P3：系统进入deepsleep；

可以通过GRF寄存器强制设置USB3.0 PHY进入P3 state，并且在P3 state下可以进一步配置USB3.0 PHY的寄存器：ldo power up, bg power on, tx bias enable, tx cm power up, tx obs enable和rx cm enable，以降低系统待机时的USB3.0 PHY功耗。表3-4给出了通过USB3 GRF控制PHY进入P3 state的寄存器说明，表3-5给出了在P3 state时，控制PHY寄存器进入低功耗的配置。

USB3 PHY P3 state低功耗的控制流程，请参考驱动：

`drivers/phy/rockchip/phy-rockchip-inno-usb3.c`

表3-4 P3 state的USB3 GRF寄存器配置

Signal	I/O	Description
pipe_pd_i[1:0]	I	PIPE Power Up/Down Power states for USB 3.0 mode: 2'b00: P0, normal operation 2'b01: P1, low recovery time latency, power saving state 2'b10: P2, longer recovery time latency, lower power state 2'b11: P3, lowest power state.

表3-5 P3 state的USB3 PHY寄存器低功耗配置

Offset	Bit	Default	Suspend	Description
0x1a8	4	1'b 0	1'b 1	ldo power down control
0x44	4	1'b 0	1'b 1	Band-gap power down control
0x150	6	1'b 1	1'b 0	tx bias enable
0x80	2	1'b 0	1'b 1	tx cm power down control
0xc0	4:3	1'b 11	2'b 00	bit3: tx obs enable bit4: rx cm enable

Note: 需要在进入P3 state后，才能关闭上述寄存器，进入suspend低功耗。在低功耗状态，USB3 PHY不能检测任何事件。如果要打开这些寄存器，需要在退出P3 state的1μs之前，将这些寄存器全部打开，然后再设置PHY进入P0 state。

3.1.5 PHY reset和recover时序要求

3.1.5.1 PHY reset时序

由于一个完整的USB3.0 PHY，实际上是由USB2.0 PHY和USB3.0 PHY组成的combo PHY，所以，reset信号包括了UTMI reset（USB2.0）和PIPE reset（USB3.0）。表3-6是RK3228H USB3.0 PHY reset信号的说明。

表3-6 Inno USB3.0 PHY reset（RK3228H）

Reset Signal	Description
usb3phy_otg_psrstn_req	UTMI APB reset
usb3phy_pipe_psrstn_req	PIPE APB reset
usb3otg_utmi_srst_req (utmi_reset)	UTMI MAC reset
usb3phy_pipe_srstn_req (pipe_rsn)	PIPE MAC reset
usb3phy_u2_srstn_req (por_reset)	USB2 power on reset
usb3phy_u3_srstn_req (por_n)	USB3 power on reset

reset的时序如下图3-3所示。

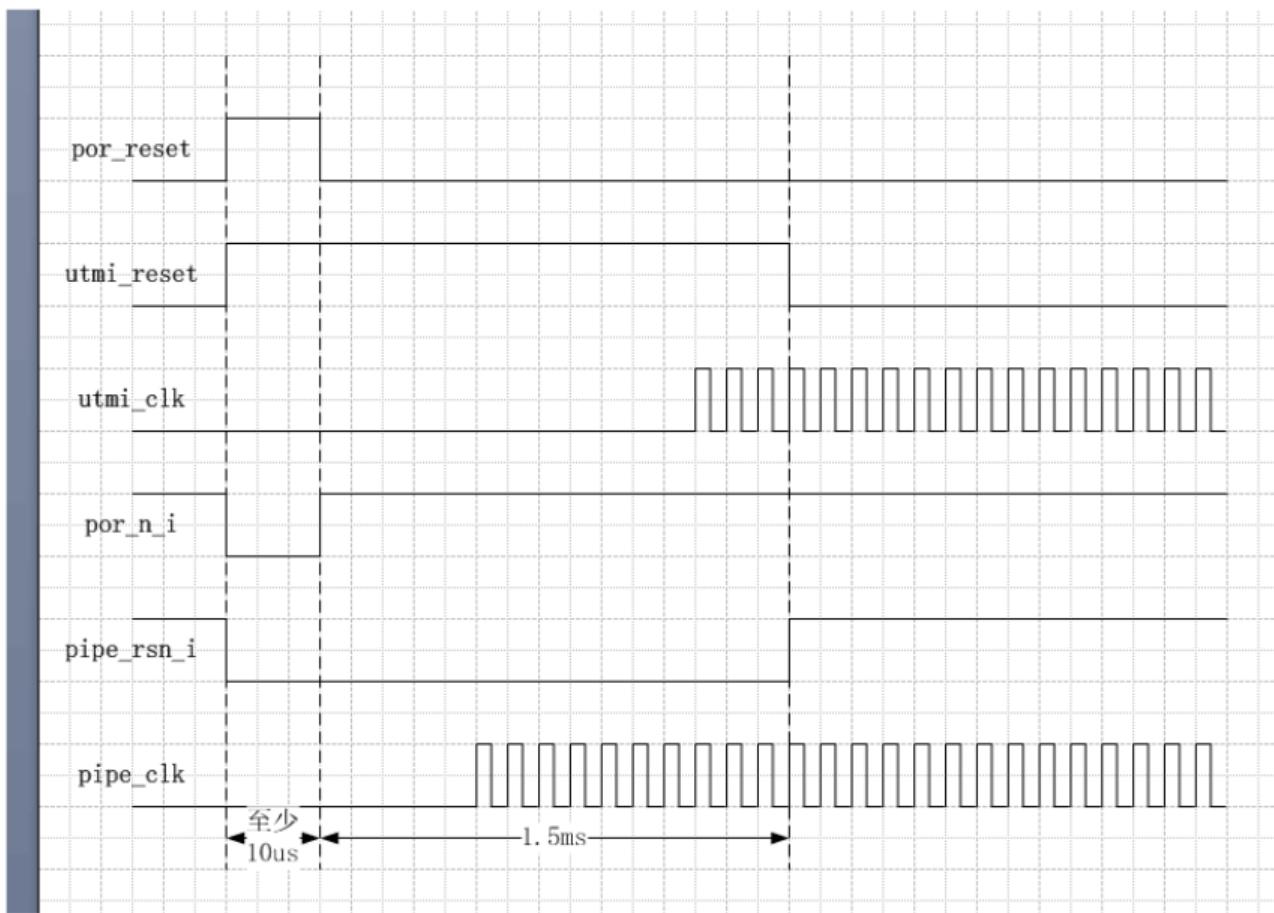


图3-3 Inno USB3.0 PHY reset sequence

3.1.5.2 PHY recover 时序

表3-6 Inno USB3.0 PHY recovery time

Recovery time	U1	U2	U3
Entry from U0	25 ns	2.5 μ s	6 μ s
Exit to U0	25 ns	2 μ s	100 μ s

U0: normal operation
U1: low recovery time latency, power saving state
U2: longer recovery time (64us max) latency, lower power state
U3: lowest power state, internal clocks can be turned off. The PIPE interface is in asynchronous mode

3.1.6 PHY tuning 流程

由于一个完整的USB3.0 PHY，实际上是由USB2.0 PHY和USB3.0 PHY组成的combo PHY，所以PHY的tuning包括USB2.0 PHY和USB3.0 PHY两部分。其中，USB2.0 PHY tuning流程，请参考 [2.1.6 PHY tuning 流程](#)。USB3 PHY的tuning，Inno 提供的文档中没有给出详细的调试方法，因此，目前只有 Rx tuning for compliance RJTL test（可用于Rx信号一致性测试）和 bias current for the PHY（可用于调整信号幅度）的调整方法。参考驱动 `drivers/phy/rockchip/phy-rockchip-inno-usb3.c` 的函数 `rk3328_u3phy_tuning`。

3.2 Cadence Type-C PHY

3.2.1 PHY 的硬件框架

Cadence Type-C PHY的硬件框架如下图3-4所示，支持USB SuperSpeed 和 DisplayPort through 4 lanes。Type-C PHY各个子模块的详细说明，请参考文档《Cadence Type-C Subsystem Integration Guide》。

Type-C PHY 可以支持如下三种工作模式：

- 4-lane DisplayPort
- 2-lane DisplayPort + USB SuperSpeed (one port)
- USB Superspeed only (one port)

Reference Type-C Subsystem

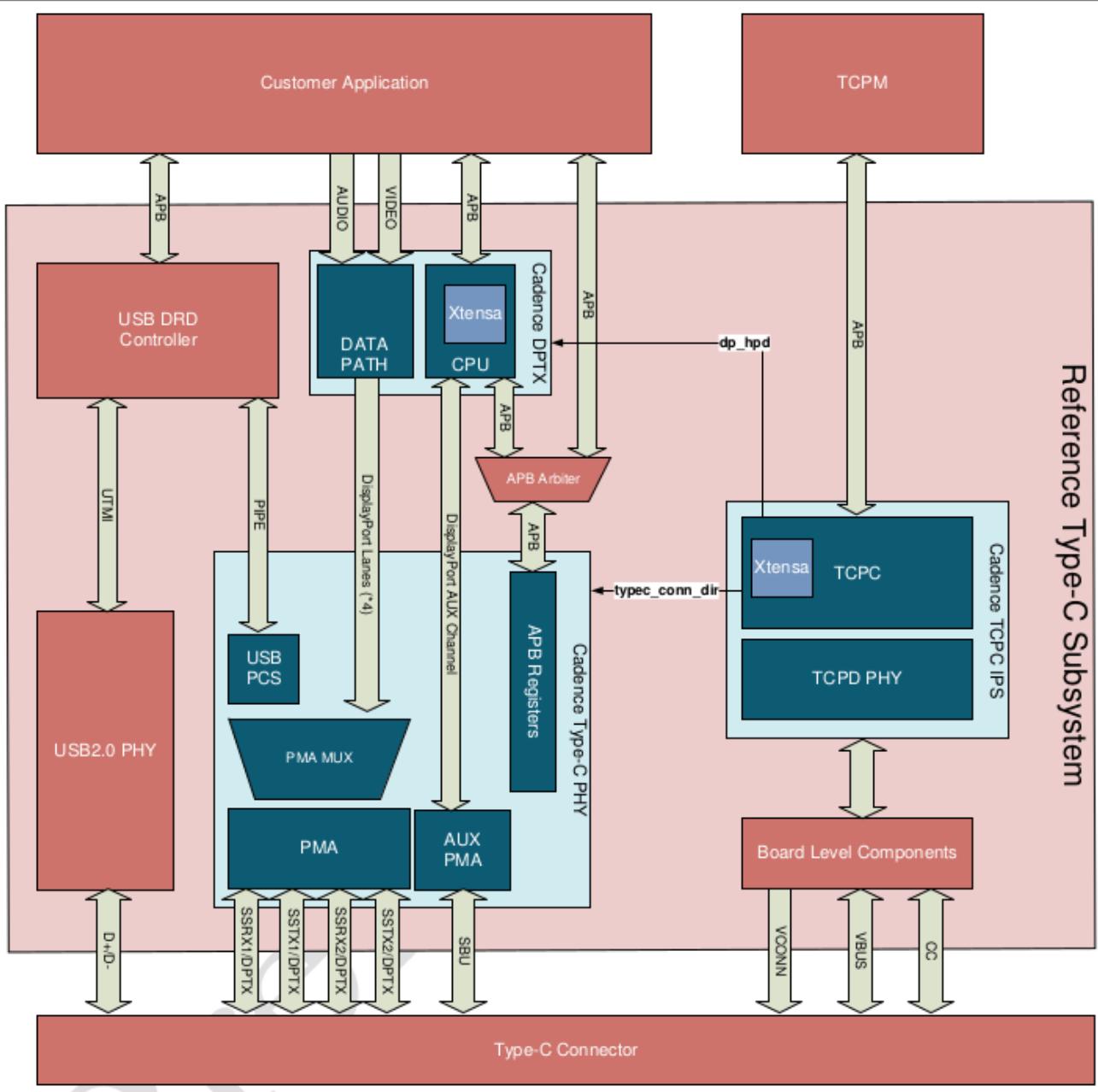


图3-4 CDNS-TYPE-C Reference HW Architecture

Type-C PHY USB3.0 Tx/Rx 和 Lanes的对应关系如下图3-5所示。

USB3.0 Tx1 --> Lane0

USB3.0 Rx1 --> Lane1

USB3.0 Rx2 --> Lane2

USB3.0 Tx2 --> Lane3

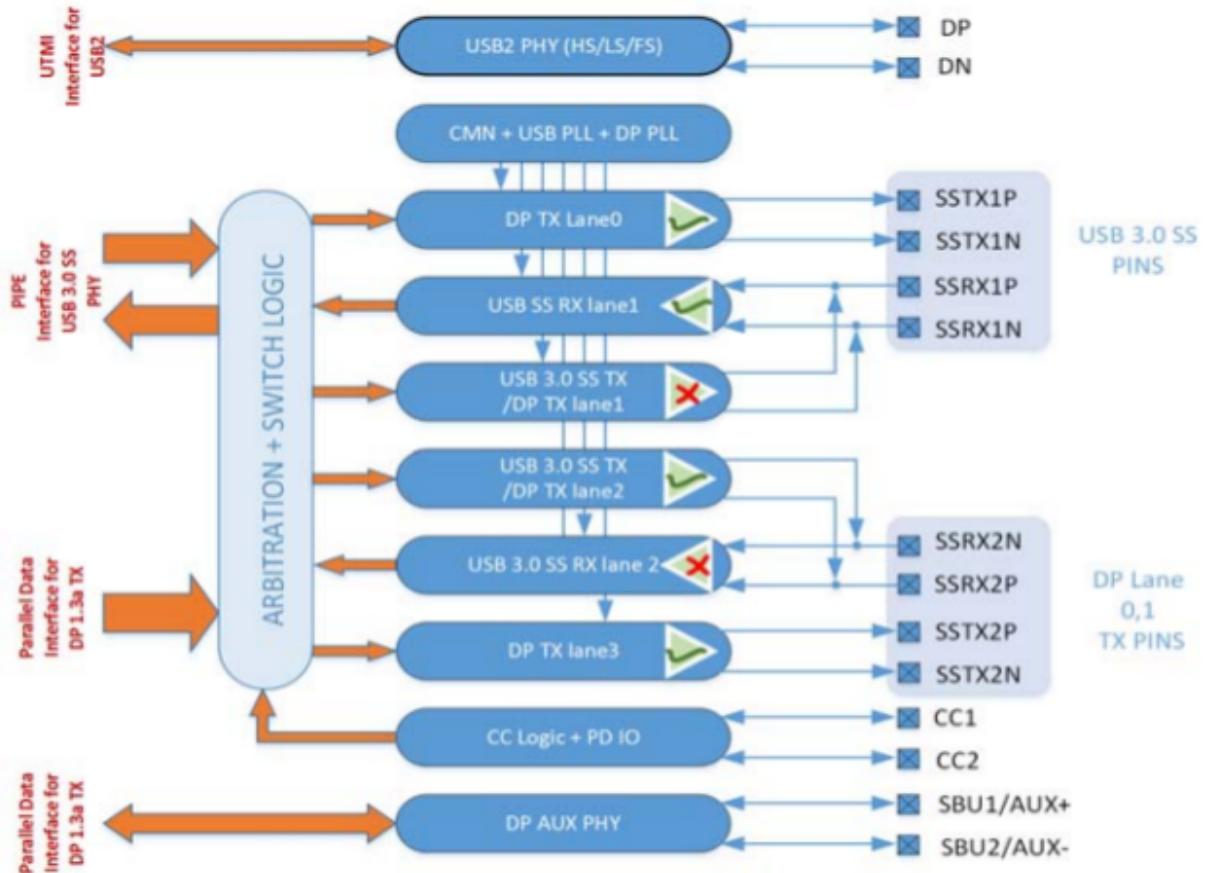


图3-5 Type-C implementation configuration with straight cable

3.2.2 主要寄存器说明

主要寄存器的说明, 请参考文档《USB3-DP Driver Capability》, 该文档提供了USB3.0和DP tuning的寄存器配置方法。对于USB3.0 Tx, 常用的寄存器是 TX_DIAG_TX_DRV 和 TX_TXCC_CAL_SCLR_MULT, 这两个寄存器可以用于调整Tx的驱动强度和幅值, 配置方法请参考补丁RK3399 Chrome 平台的补丁“CHROMIUM: phy: rockchip-typec: tuning phy for usb3 Rx flip” 和 “CHROMIUM: phy: rockchip-typec: tuning phy for usb3 Tx”。

Type-C PHY的寄存器偏移地址计算方法比较复杂, 需要遵循两个规则:

- 每条lane都有自己对应的寄存器偏移地址
- 通过查表得到的寄存器偏移地址为16bit, 需要再左移 2 bits, 才是最终的偏移地址。

以lane3 (对应USB3.0 Tx2)寄存器 TX_DIAG_TX_DRV 的偏移地址计算为例:

1. 通过查表, 得到 TX_DIAG_TX_DRV 的寄存器地址为 01_m_nnnn : 1111 : 00001

其中, m = multi-write, nnnn = lane number

lane0 Tx1 nnnn = 0x0 lane1 Rx1 nnnn = 0x1 lane2 Rx2 nnnn = 0x2 lane3 Tx2 nnnn = 0x3

2. 计算 lane3 TX_DIAG_TX_DRV 寄存器的偏移地址

lane3-TX_DIAG_TX_DRV = 01_0_0011 : 1111 : 00001 = 0x47E1

3. 左移 2 bits, 获得最终的偏移地址

lane3-TX_DIAG_TX_DRV = 0x47E1 << 2 = 0x11F84

3.2.3 参考电阻说明

根据文档《USB Type-C with DisplayPort Transmit PHY Specification》，Type-C外部参考电阻如下表3-7所示。

表3-7 Type-C PHY参考电阻

Name	Min	Typ	Max	Unit	Descriptions
rext	497.5	500	502.5	Ω	There needs to be an external resistor component that needs to be connected at rext ball while internal resistor or current is getting calibrated. Package routing from rext ball to its respective bump should not contribute more than 0.05Ω.
aux_pullup	—	100k	—	Ω	AUX port pull-up resistance
aux_pulldown	—	100k	—	Ω	AUX port pull-down resistance

Note: RK3399 EVB的Type-C REXT 采用的电阻为 $499 \pm 1\% \Omega$

3.2.4 PHY 的供电及功耗管理

3.2.4.1 PHY 的供电

根据文档《USB Type-C with DisplayPort Transmit PHY Specification》，Type-C PHY的供电要求如下：

Analog Supply Voltage: 0.9 V, 1.8 V, and 3.3 V ($\pm 10\%$)

Digital Supply Voltage: 0.9 V ($\pm 10\%$)

3.2.4.2 PHY 的功耗管理

Type-C PHY的功耗控制可以通过两个途径：

1. Assert Type-C PHY 相关的reset信号；
2. 关闭 Type-C PHY 的power domain；

3.2.5 PHY reset

RK3399 Type-C PHY的reset 信号有3个：phy reset, pipe reset 和 apb reset。

表3-8 Type-C PHY reset (RK3399)

Reset Signal	Description
resetn_uphy1_req	Type-C1 phy reset
resetn_uphy1_pipe_l00_req	Type-C1 pipe reset
resetn_uphy1_tcpphy_req	Type-C1 apb reset
resetn_uphy0_req	Type-C0 phy reset
resetn_uphy0_pipe_l00_req	Type-C0 pipe reset
resetn_uphy0_tcpphy_req	Type-C0 apb reset

根据RK3399 datasheet “7.5.1 Start-up sequence”， reset的时序要求如下：

USB Start-up Sequence:

- Select external PSM clock (see Chapter GRF)
- Set select Type-C PHY0 or Type-C PHY1 used for DPTX
- Reset whole Type-C PHY, assert apb_preset_n, pipe_reset_n and phy_reset_n (see Chapter CRU)
- Release apb_preset_n
- Configure Type-C PHY normal or flipped orientation
- Configure PHY and PMA for the selected mode of operation
- Release phy_reset_n
- Wait for CMN ready indication (assertion) by polling bit 0 of PHY_PMA_CNN_CTRL1 of PHY
- Release pipe_reset_n
- Wait for the de-assertion of pipe_phy_status, then Type-C PHY for USB operation is ready.

3.2.6 PHY tuning 流程

Type-C PHY的tuning, 请参考文档《USB3-DP Driver Capability》，该文档提供了USB3.0和DP tuning的寄存器配置方法。对于USB3.0 Tx tuning, 常用的寄存器是 TX_DIAG_TX_DRV 和 TX_TXCC_CAL_SCLR_MULT, 这两个寄存器可以用于调整Tx的驱动强度和幅值。对于USB3.0 Rx tuning, 常用的寄存器是 RX_DIAG_RXFE_TM2, TX_DIAG_TX_DRV 和 TX_TXCC_CAL_SCLR_MULT, 配置方法请参考补丁RK3399 Chrome 平台的补丁“CHROMIUM: phy: rockchip-typec: tuning phy for usb3 Rx flip”和“CHROMIUM: phy: rockchip-typec: tuning phy for usb3 Tx”。

4 PHY常见问题总结

4.1 通过tuning USB2.0 PHY 可以解决哪些问题

1. 调整USB眼图的幅度和斜率（slew rate），解决眼图指标测试失败的问题；

比如Inno USB2.0 PHY的眼图tuning, 可参考 [2.1.6 PHY tuning 流程](#)

2. 解决由于USB信号质量问题或者PHY供电压差问题引起的USB枚举失败、异常断开等问题；

4.2 通过调整噪声阈值解决USB HS设备枚举失败的问题

1. 现象：使用质量较差、阻抗较大的 USB cable 连接HS外设，无法枚举HS设备。使用这类 USB cable 来测试眼图，结果一般很差，幅度较低，如图4-1所示。

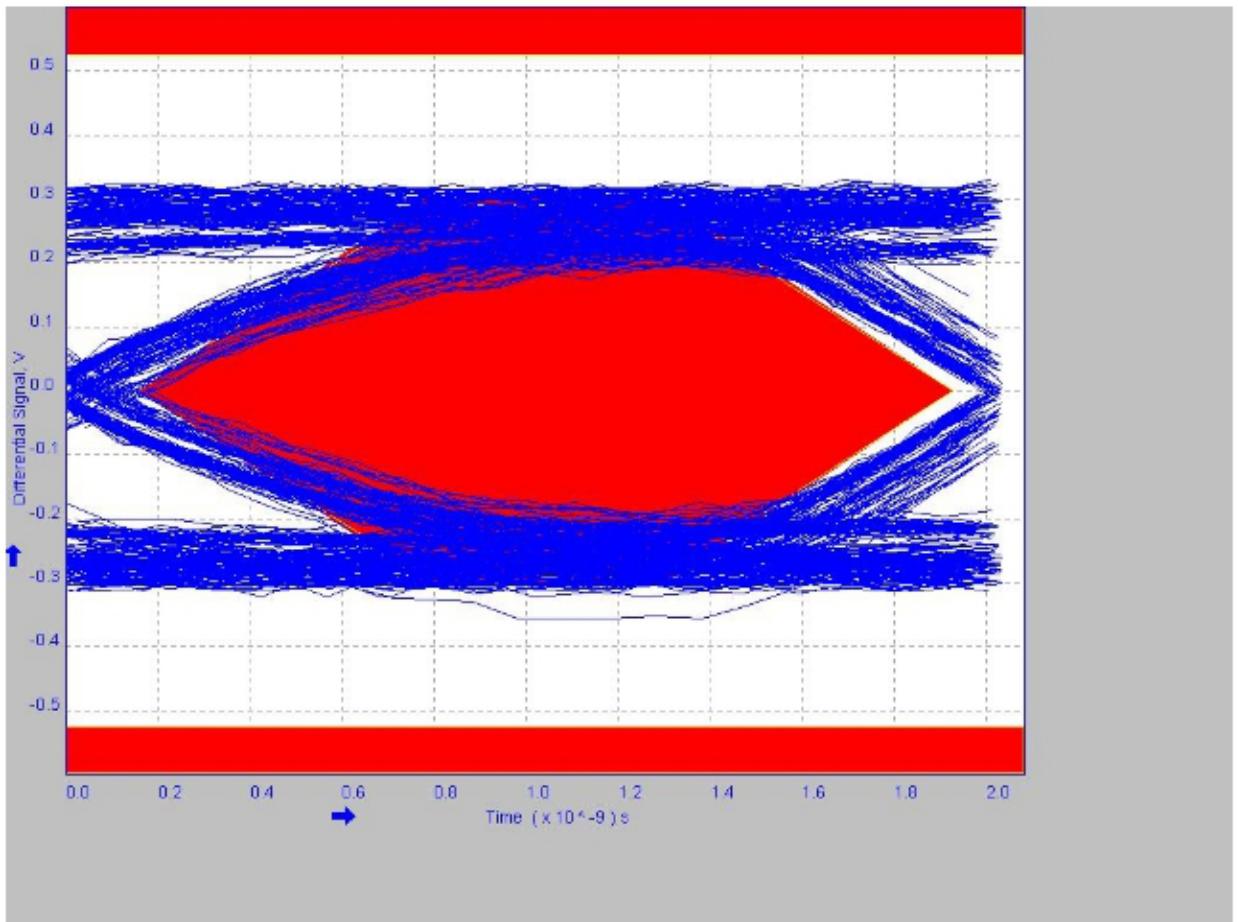


图4-1 幅值低于噪声阈值的USB眼图

2. 原因：USB PHY的噪声阈值默认设置为 150 mV，但当使用阻抗较大的USB cable时，USB正常信号的幅值会衰减得很厉害，甚至低于150 mV的，因此正常信号会被当作噪声处理了。
3. 解决方法：根据USB2.0 spec “Table 7-3. High-speed Signaling Levels (Continued)”，USB HS的噪声阈值是可以低于150mV的。因此，可以降低USB2 PHY的噪声阈值至 125 mV 或者 112.5 mV。对于Inno USB 2.0 PHY，请参考 [2.1.2 主要寄存器说明](#) 的寄存器[16:13]；对于Synopsys USB2.0 PHY，请参考[2.2.2 主要寄存器说明](#)的寄存器 SQRTUNE[2:0]。

4.3 通过调整断开检测阈值解决USB异常断开的问题

1. 现象：USB Host 连接外设，在使用过程中，外设异常disconnect，没有其他报错信息。
2. 原因：可能是USB差分信号幅值太大，触发了PHY的disconnect 阈值，导致PHY误检测到设备拔出。
3. 解决方法：对于Inno USB 2.0 PHY，disconnect 阈值可以通过PHY的寄存器进行调整。参考 [2.1.2 主要寄存器说明](#) 中的寄存器[126:123]，disconnect threshold 默认设置为 650 mV，如果改为 600 mV以下，可能偏小，容易触发disconnect中断。对于Synopsys USB2.0 PHY，请参考 [2.2.2 主要寄存器说明](#)的寄存器 COMPDISTUNE[2:0]。

4.4 通过B_sessionvalid reference tuning解决ADB连接问题

1. 现象：PC无法识别ADB，或者识别到ADB后又断开。
2. 原因：该问题经常出现在使用 Inno USB2.0 PHY 的USB接口。导致ADB连接失败的硬件问题主要有三种：1. Vbus电压太低（一般低于4.7V 容易出现问题）；2. USB_AVDD_1V0 纹波太高，或者USB_AVDD_1V0 被抬高到 1.2V，导致PHY检测不到Bvalid有效信号；3. Logic 电压纹波太高，导致USB控制器工作异常。

3. 解决方法：可以通过调整 Inno USB2.0 PHY 寄存器的 B_sessionvalid reference tuning 解决。参考 [2.1.2 主要寄存器说明](#) 中的寄存器[108:106]，默认值为 3'b000，建议改为 3'b111 或 3'b101。

4.5 Innosilicon LS/FS 信号问题

1. LS Rise/Fall time test fail 的原因是什？为什么 Inno 没有提供 LS tuning 的 PHY 寄存器？

[Inno reply]:

LS/FS 属于早期USB1.0/1.1 的范畴，信号 swing 为3.3v，属于低速大信号逻辑电平。rise/ fall time 一方面和驱动能力相关，另一方面和负载电容相关，driver 本身很简单，就是大的 PMOS/NMOS 互补输出，除了实用性和 die size 考虑，rise/fall time 控制需要的 muti-stage delay cell 在130nm 以下的节点上优化掉。driver 本身的 R 和 PCB 上的 C 决定了 Tr/Tf。

2. LS Rise/Fall time test fail 的解决方法

[Inno reply]:

建议软件根据目前 PHY 的工作速度，LS 单独配驱动强度，FS/HS 共享一组 ODT 设置。这样可以避免有眼图 fail 的情况，也无需硬件的改动，且无兼容性风险。因为 LS/FS 本身的速度只有 12M/1.5Mbps，速度足够低，且在实际应用中绝大多数设备都是 USB2.0 以上的标准，HS 是标配。不会使用到 FS/LS 模式。

3. 如果软件无法 workaround，LS Rise/Fall time test fail 是否会影响 usb 实际使用的兼容性？

[Inno reply]:

目前在 USB2.0/3.0 的主流应用中已经不再是 critical 选项，SPEC 上 eye 也不再作为强制指标，在 function 上绝对无任何兼容性的问题，完全可以放心，从实际使用和软件完整性角度考虑，建议 LS rise/fall time 不作处理。以 HS/FS 指标优先。

4.7 RK312x/RK3368 HS 握手失败问题

- 现象：RK312x/RK3368 的 PHY 由于兼容性问题，无法识别个别型号的U盘（一般为 Kingston U盘），表现的出错现象是，在 EHCI port 挂载速度变慢（识别为全速设备），在 OTG port 无法识别。但如果如外接HUB，则正常识别HS。
- 原因：U盘在高速握手时会发送异常的信号，位置在 chirp K 后面，host KJ 对前面。是一个类似脉冲的形式，展开后是有 sync EOP 的不完整的数据。该异常信号会导致PHY进入异常的状态，并且无法恢复。
- 解决方法：软件强制控制器运行在Full speed（参考补丁“0001-USB-dwc_otg_310-hcd-force-fs-if-phy-in-rx-active-sta.patch”），应用在这些无法识别的U盘，目前没有其它 workaround 的办法，除非芯片硬件ECO。Inno 已经在后续的 USB2.0 PHY 版本中解决该兼容性问题，所以该问题只存在于 RK312x/RK3368 的 USB2.0 PHY。

4.8 RK3228H/RK3328 USB3.0 PHY 若干问题

1. 3238H USB IP 问题总结：

- USB3.0 Port U2 眼图中有6根离散的线；
- USB3.0 PHY 的 RX 指标测试 Fail，需要软件 tuning phy；
- USB3.0 PHY 的 1.0V VDD 在上电期间有 1A 以上的大电流；
- USB3.0 PHY 无法检测到外设拔出的 disconnect；
- USB3.0 PHY 在 P3 state，link training 失败，导致无法识别外设。目前运行时的低功耗，只能设置在 P2 state，功耗偏高。同时，在 P2 state 时，外接 hub 的 auto-suspend 和 remote-wakeup 有异常，需要 disable hub 的 auto-suspend 功能（在 P3 state 时，无该异常）。

2. 3238H MPW 改版 USB IP 修正：

- 修改switch MOS 尺寸

解决了USB3.0 Port U2的眼图中有6根离散的线，导致指标临界的问题。

- 增加寄存器调节范围，细化步长

解决了USB3.0 PHY的RX指标测试和部分U盘不识别的问题；

RX jitter tolerance 有一定的改善；

- 修改clamp RC常数

解决了USB3.0 PHY的1.0V VDD上电期间的大电流问题。

- 修改逻辑，增加back up方案

解决了当USB3.0的device拔出后，USB控制器检测不到disconnect。原因是USB3 PHY的检测电路中滤毛刺电路的bug，导致PHY不能回到初始状态。

- 修改USB2 host/otg combo PHY的ESD，解决RK3228H的版本HMB ESD指标测试Fail的问题

3. 3238H USB PHY遗留问题

- USB3.0 PHY 在 P3 state，link training 失败，导致无法识别外设。